Ürün kataloğu

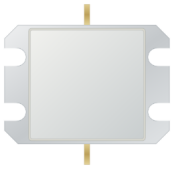
# RF güç transistörleri

RF güç transistörleri, öngerilim ve RF sürme sinyalini yükselteç kademesinde kullanılabilir çıkış gücüne dönüştüren aktif yarı iletkenlerdir. Verici zincirleri, güç modülleri, endüstriyel RF ekipmanı ve yüksek güçlü test donanımında kullanılır.



Ürünler: 11

Revizyon: 9 · Revizyon tarihi: 2026-11-11



## LCT-5700-7100-PS51T

**5700–7100 MHz GaN İçten Eşlenmiş Güç Transistörü — PSAT 51 dBm (tipik)**

5700–7100 MHz; PSAT 51 dBm (tipik); Güç kazancı 11 dB (tipik); PAE 45 % (tipik).

**Çalışma frekansı:** Sembol: f; Minimum: 5700; Maksimum: 7100; Değer: 5700–7100; Birim: MHz

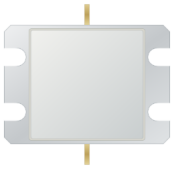
**Doyum çıkış gücü:** Minimum: 50.5; Tipik: 51; Birim: dBm

**Güç kazancı:** Minimum: 10.5; Tipik: 11; Birim: dB

**Eklenen güç verimi:** Minimum: 40; Tipik: 45; Birim: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Ürün ayrıntıları  Ürün veri sayfası



## LCT-2700-3500-PS56p5T

**2700–3500 MHz GaN İçten Eşlenmiş Güç Transistörü — PSAT 56.5 dBm (tipik)**

2700–3500 MHz; PSAT 56.5 dBm (tipik); Güç kazancı 13.5 dB (tipik); PAE 55 % (tipik).

**Çalışma frekansı:** Sembol: f; Minimum: 2700; Maksimum: 3500; Değer: 2700–3500; Birim: MHz

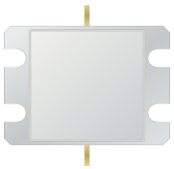
**Doyum çıkış gücü:** Minimum: 56; Tipik: 56.5; Birim: dBm

**Güç kazancı:** Minimum: 13; Tipik: 13.5; Birim: dB

**Eklenen güç verimi:** Minimum: 50; Tipik: 55; Birim: %

TA = +25 °C; VDS = 44 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 300 µs; D = 10%

Ürün ayrıntıları  Ürün veri sayfası



## LCT-5300-5900-PS56p5T

**5300–5900 MHz GaN İçten Eşlenmiş Güç Transistörü — PSAT 56.5 dBm (tipik)**

5300–5900 MHz; PSAT 56.5 dBm (tipik); Güç kazancı 12.5 dB (tipik); PAE 45 % (tipik).

**Çalışma frekansı:** Sembol: f; Minimum: 5300; Maksimum: 5900; Değer: 5300–5900; Birim: MHz

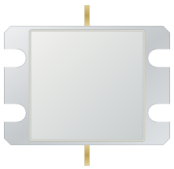
**Doyum çıkış gücü:** Minimum: 56; Tipik: 56.5; Birim: dBm

**Güç kazancı:** Minimum: 12; Tipik: 12.5; Birim: dB

**Eklenen güç verimi:** Minimum: 40; Tipik: 45; Birim: %

TA = +25 °C; VDS = 40 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 10 µs; D = 1%

Ürün ayrıntıları  Ürün veri sayfası



## LCT-2700-3900-PS48p5T

**2700–3900 MHz GaN İçten Eşlenmiş Güç Transistörü — PSAT 48.5 dBm (tipik)**

2700–3900 MHz; PSAT 48.5 dBm (tipik); Güç kazancı 12.5 dB (tipik); PAE 50 % (tipik).

**Çalışma frekansı:** Sembol: f; Minimum: 2700; Maksimum: 3900; Değer: 2700–3900; Birim: MHz

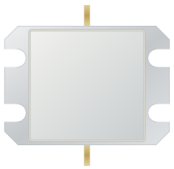
**Doyum çıkış gücü:** Minimum: 48; Tipik: 48.5; Birim: dBm

**Güç kazancı:** Minimum: 12; Tipik: 12.5; Birim: dB

**Eklenen güç verimi:** Minimum: 45; Tipik: 50; Birim: %

TA = +25 °C; VDS = 24–28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Ürün ayrıntıları  Ürün veri sayfası



## LCT-2700-3500-PS53p5T

**2700–3500 MHz GaN İçten Eşlenmiş Güç Transistörü — PSAT 53.5 dBm (tipik)**

2700–3500 MHz; PSAT 53.5 dBm (tipik); Güç kazancı 13.5 dB (tipik); PAE 65 % (tipik).

**Çalışma frekansı:** Sembol: f; Minimum: 2700; Maksimum: 3500; Değer: 2700–3500; Birim: MHz

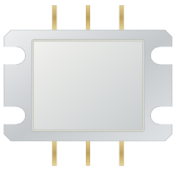
**Doyum çıkış gücü:** Minimum: 53; Tipik: 53.5; Birim: dBm

**Güç kazancı:** Minimum: 13; Tipik: 13.5; Birim: dB

**Eklenen güç verimi:** Minimum: 60; Tipik: 65; Birim: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Ürün ayrıntıları  Ürün veri sayfası



## LCT-2300-3900-PS50T

**2300–3900 MHz GaN İçten Eşlenmiş Güç Transistörü — PSAT 50 dBm (tipik)**

2300–3900 MHz; PSAT 50 dBm (tipik); Güç kazancı 12 dB (tipik); PAE 50 % (tipik).

**Çalışma frekansı:** Sembol: f; Minimum: 2300; Maksimum: 3900; Değer: 2300–3900; Birim: MHz

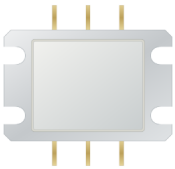
**Doyum çıkış gücü:** Minimum: 49; Tipik: 50; Birim: dBm

**Güç kazancı:** Minimum: 11; Tipik: 12; Birim: dB

**Eklenen güç verimi:** Minimum: 45; Tipik: 50; Birim: %

TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Ürün ayrıntıları  Ürün veri sayfası



## LCT-2600-3700-PS49T

**2600–3700 MHz GaN İçten Eşlenmiş Güç Transistörü — PSAT 49 dBm (tipik)**

2600–3700 MHz; PSAT 49 dBm (tipik); Güç kazancı 13 dB (tipik); PAE 50 % (tipik).

**Çalışma frekansı:** Sembol: f; Minimum: 2600; Maksimum: 3700; Değer: 2600–3700; Birim: MHz

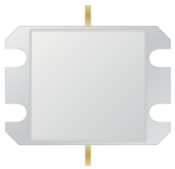
**Doyum çıkış gücü:** Minimum: 48; Tipik: 49; Birim: dBm

**Güç kazancı:** Minimum: 12; Tipik: 13; Birim: dB

**Eklenen güç verimi:** Minimum: 45; Tipik: 50; Birim: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 36 dBm; CW

Ürün ayrıntıları  Ürün veri sayfası



## LCT-8500-9600-PS51T

**8500–9600 MHz GaN İçten Eşlenmiş Güç Transistörü — PSAT 51 dBm (tipik)**

8500–9600 MHz; PSAT 51 dBm (tipik); Güç kazancı 9 dB (tipik); PAE 38 % (tipik).

**Çalışma frekansı:** Sembol: f; Minimum: 8500; Maksimum: 9600; Değer: 8500–9600; Birim: MHz

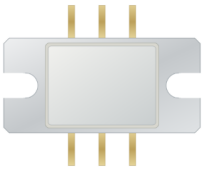
**Doyum çıkış gücü:** Minimum: 50; Tipik: 51; Birim: dBm

**Güç kazancı:** Minimum: 8; Tipik: 9; Birim: dB

**Eklenen güç verimi:** Tipik: 38; Birim: %

Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm

Ürün ayrıntıları  Ürün veri sayfası



## LCT-2000-6000-PO45p51T

**2000–6000 MHz GaN İçten Eşlenmiş Güç Transistörü — Pout 45.51 dBm @ 6000 MHz (tipik)**

2000–6000 MHz; Referans çıkış gücü 45.51 dBm (tipik); Güç kazancı 19.51 dB (tipik); Dren verimi 39.82 % (tipik) @ 6000 MHz.

**Çalışma frekansı:** Sembol: f; Minimum: 2000; Maksimum: 6000; Değer: 2000–6000; Birim: MHz

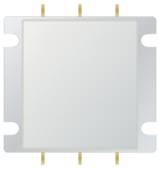
**Referans çıkış gücü:** Tipik: 45.51; Birim: dBm; Notlar: f = 6000 MHz

**Güç kazancı:** Tipik: 19.51; Birim: dB; Notlar: f = 6000 MHz

**Dren verimi:** Sembol: ηD; Tipik: 39.82; Birim: %; Notlar: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1.3 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 26 dBm

Ürün ayrıntıları  Ürün veri sayfası



## LCT-700-6200-PS49T

**700–6200 MHz GaN İçten Eşlenmiş Güç Transistörü — PSAT 49 dBm @ 6000 MHz (tipik)**

700–6200 MHz; Doyum çıkış gücü 49 dBm (tipik); Güç kazancı 7 dB (tipik); Dren verimi 35 % (tipik) @ 6000 MHz.

**Çalışma frekansı:** Sembol: f; Minimum: 700; Maksimum: 6200; Değer: 700–6200; Birim: MHz

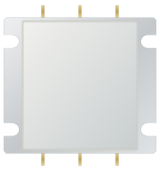
**Doyum çıkış gücü:** Sembol: Psat; Tipik: 49; Birim: dBm; Notlar: f = 6000 MHz

**Güç kazancı:** Tipik: 7; Birim: dB; Notlar: f = 6000 MHz

**Dren verimi:** Sembol: ηD; Tipik: 35; Birim: %; Notlar: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1 A; CW; f = 6000 MHz

Ürün ayrıntıları  Ürün veri sayfası



## LCT-2000-6200-PO50p1T

**2000–6200 MHz GaN İçten Eşlenmiş Güç Transistörü — Pout 50.1 dBm @ 6000 MHz (tipik)**

2000–6200 MHz; Referans çıkış gücü 50.1 dBm (tipik); Güç kazancı 8.6 dB (tipik); Dren verimi 52.4 % (tipik) @ 6000 MHz.

**Çalışma frekansı:** Sembol: f; Minimum: 2000; Maksimum: 6200; Değer: 2000–6200; Birim: MHz

**Referans çıkış gücü:** Tipik: 50.1; Birim: dBm; Notlar: f = 6000 MHz

**Güç kazancı:** Tipik: 8.6; Birim: dB; Notlar: f = 6000 MHz

**Dren verimi:** Sembol: ηD; Tipik: 52.4; Birim: %; Notlar: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 0.5 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 41.5 dBm

Ürün ayrıntıları  Ürün veri sayfası

**Belge notu**

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.